

Silicon PIN Diode

BA779S

30V / 50mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 779 · BA 779 S

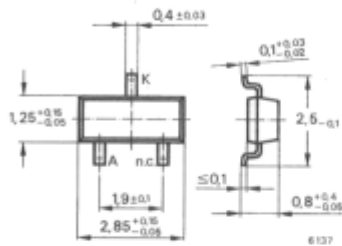
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:

- Großer Frequenzbereich 10 MHz ... 1 GHz

Abmessungen in mm



Standard Kunststoffgehäuse
23 A3 DIN 41869/8
JEDEC TO 236
SOT 23
Gewicht max. 0,02 g

Bestempfung: BA 779 PN
BA 779 S + PN

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55 ... + 125	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
--	------------	-----	-----

Kenngößen.

$T_{amb} = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung					
$I_F = 20\text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom					
$U_R = 30\text{ V}$	I_R			50	nA
Diodenkapazität					
$U_R = 0, f = 100\text{ MHz}$	C_D			0.5	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand					
$I_F = 1.5\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	r_f			50	Ω
Sperrimpedanz					
$U_R = 0, f = 100\text{ MHz}$	z_r		5		kΩ
	z_r		9		kΩ

BA 779 · BA 779S

